

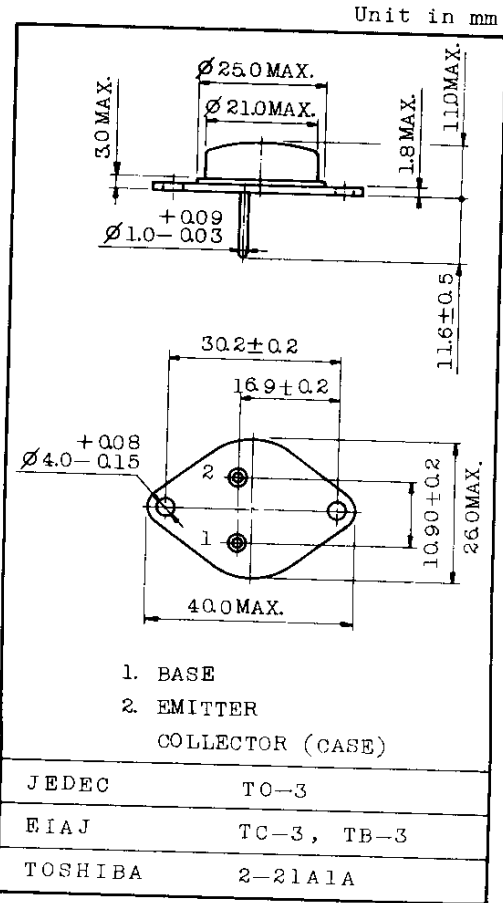
シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ  
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

# 2SD665

- 電力増幅用
- Power Amplifier Applications.
- 高耐圧です。:  $V_{CE0} = 200V$
- トランジション周波数が高い。:  $f_T = 15\text{ MHz (Typ.)}$
- 2SB645とコンプリメンタリになります。
- 200W ハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。
- Complementary to 2SB645.
- Recommended for 200W High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	200	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	200	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	15	A
エミッタ電流	$I_E$	-15	A
コレクタ損失 ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ )	$P_C$	150	W
接合温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-65~150	$^\circ\text{C}$



アクセサリは AC73 を適用  
MOUNTING KIT No. AC73

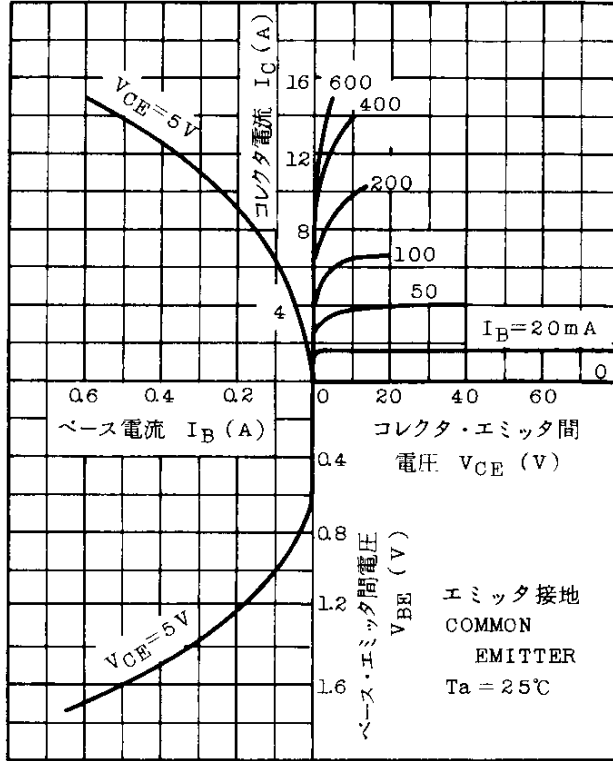
電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = 100V, I_E = 0$	-	-	100	$\mu\text{A}$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$	-	-	100	$\mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 0.1A, I_B = 0$	200	-	-	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 10\text{mA}, I_C = 0$	5	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE}$ (Note)	$V_{CE} = 5V, I_C = 1A$	40	-	140	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 5A, I_B = 0.5A$	-	-	2.0	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = 5V, I_C = 5A$	-	-	1.5	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = 10V, I_C = 1A$	-	15	-	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$	-	300	-	pF

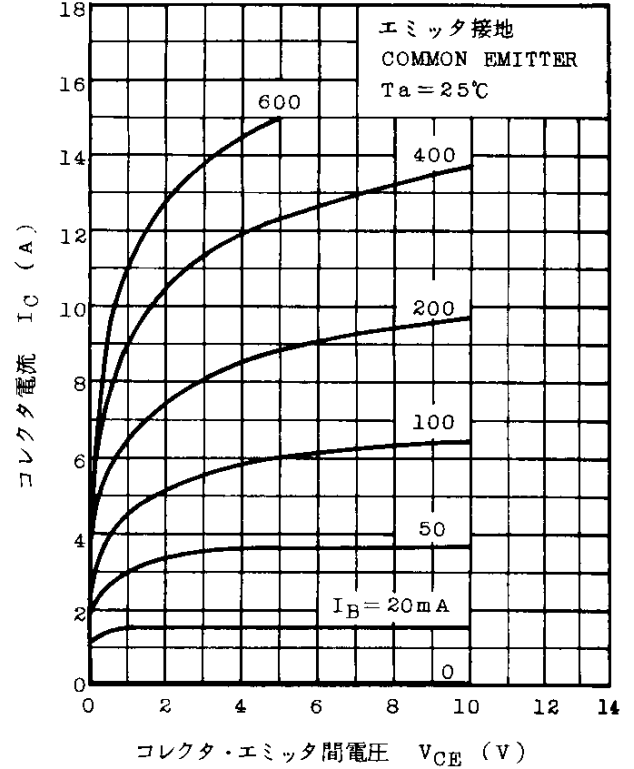
Note:  $h_{FE}$  区分 /  $h_{FE}$  classification R: 40~80, O: 70~140

# 2SD665

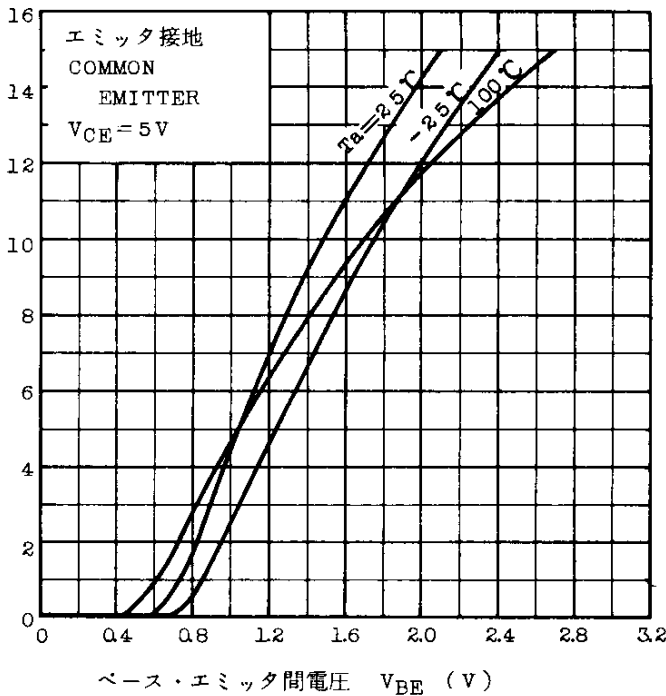
STATIC CHARACTERISTICS



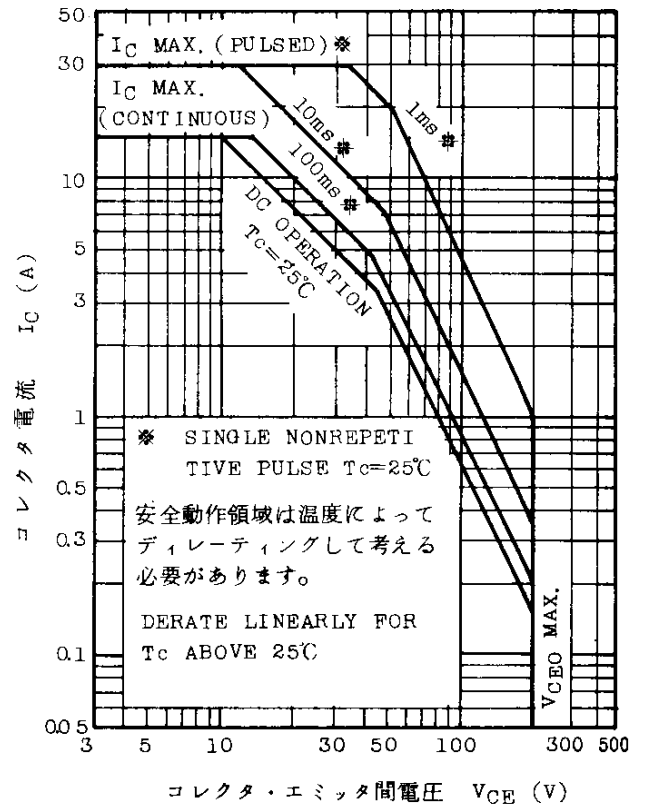
$I_C - V_{CE}$  (LOW VOLTAGE REGION)



$I_C - V_{BE}$



安全動作領域 ASO



# 2SD665

